

لیزر گاز کربنیک تپی عرضی فشار آتمسفری با نرخ تکرار بالا و توان متوسط ۲۲۰ وات

منصور زند، سعید امین نعیمی و محسن منتظرالقائم

پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران

پست الکترونیکی: mzand@aeoi.org.ir

(دریافت مقاله: ۸۶/۴/۱۵ ؛ دریافت نسخه نهایی: ۸۷/۱/۱۸)

چکیده

در این مقاله طراحی و مشخصات کارکرد یک دستگاه لیزر گازکربنیک تپی عرضی فشار آتمسفری تکرار بالا با پیش‌یونش فرابینفشن و با استفاده از گازهای صنعتی با خلوص معمولی گزارش می‌شود. آرایه‌ای از ترکیب جرقه و کرونا مناسب برای عملکرد با عمر زیاد و تکرار بالا با بهره منع پیش‌یونش کننده استفاده شده است. عملکرد نیمه بسته با تکرار ۳۰۰ هرتز و با توان متوسط ۲۲۰ وات برای اولین بار در ایران برای این نوع لیزرها به دست آمده است. در این حالت، بهره ۷/۷ درصد، انرژی در هر پالس ۷۳۵ میلی ژول اندازه‌گیری شده است. بهترین نتایج مستقل به دست آمده عبارتند از ۱/۱ ژول در تپ، ۳۲۰ هرتز نرخ تکرار، ۱۱ مگاوات قله توان و ۱۰/۶ درصد بهره خروجی نسبت به انرژی ذخیره شده در خازن اصلی.

واژه‌های کلیدی: لیزر گازکربنیک، لیزر با توان بالا، لیزر تپی فشار آتمسفری

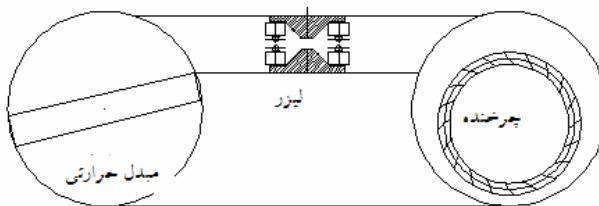
دستگاههای قبلی [۱۰-۱۳] و جهت بخش خصوصی به عنوان علامت زن روی قطعات پلاستیکی، طراحی شده است. این لیزر از یک محفظه فلزی، یک مدولاتور و یک منبع تغذیه ۱۵ کیلوولتی تشکیل شده است، در این محفظه سه قسمت اصلی وجود دارد، در سمت راست پنکه‌های محوری با چرخش ۴۵۰° دور در دقیقه عمل جابه‌جایی سریع گاز را با سرعت ۱۳ متر در ثانیه در بین الکترودها انجام می‌دهند. سرعت گاز با استفاده از اختلاف فشار در شیپور و تصوری اندازه‌گیری شده است. در ناحیه وسط، الکترودها و در دو طرف آنها، خازنهای پیش‌یونش و صفحات مولد کرونا و گپ جرقه قرار دارند. جنس الکترودها و صفحات مولد کرونا از آلومینیوم و شکل آنها به صورت دایره‌ای و با ضخامت ۰/۲۵mm می‌باشند.

در سمت چپ نیز مبدل‌های حرارتی، گرمای گاز را به آب عبوری از آن منتقل می‌کنند. طول الکترودها ۸۵ cm و عرض و فاصله

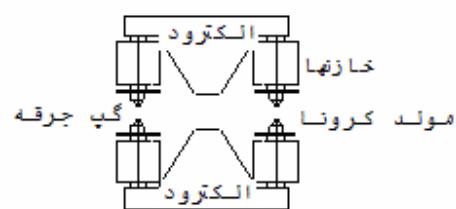
۱. مقدمه کاربردهای متنوعی برای لیزر گازکربنیک تپی عرضی فشار آتمسفری تکرار بالا، به لحاظ داشتن توان لحظه‌ای و انرژی بالا در هر تپ، در علوم و صنایع مختلف مخصوصاً علوم هسته‌ای [۱] وجود دارد، برای مثال می‌توان به کاربردهای آن به عنوان ابزاری جهت حکاکی و علامت زنی [۲]، گداخت لیزری [۳]، شتاب ذرات با استفاده از لیزر [۴] و لیدار لیزری [۵] اشاره کرد. مشکل اصلی در این گونه لیزرها، ایجاد پیش‌یونش در محیط گازی، قبل از دشواری اصلی است. در این زمینه می‌توان به بعضی روش‌های مختلف استفاده شده مثل جرقه‌های مولد پرتو فرابینفس [۶]، ایجاد کرونا [۷]، پرتو X [۸] و پرتو الکترونی [۹] جهت ایجاد پیش‌یونش اشاره کرد. کارهای متعددی نیز در ایران انجام شده است که ازان میان می‌توان به مراجع [۱۰-۱۳] اشاره کرد.

۲. ساختار لیزر

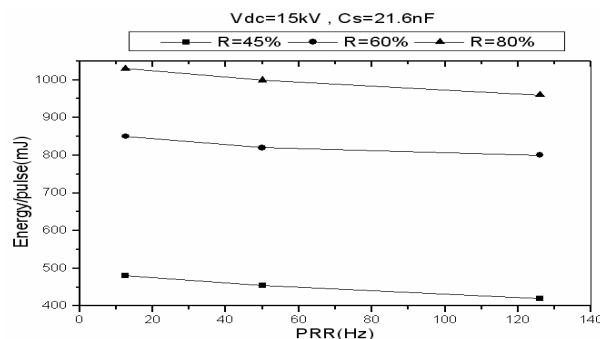
این لیزر گازکربنیک بر اساس اطلاعات به دست آمده از



شکل ۲. نمای کلی محفظه شامل کانال تخلیه الکتریکی (وسط)، مبدل حرارتی (چپ) و چرخنده گاز (راست).

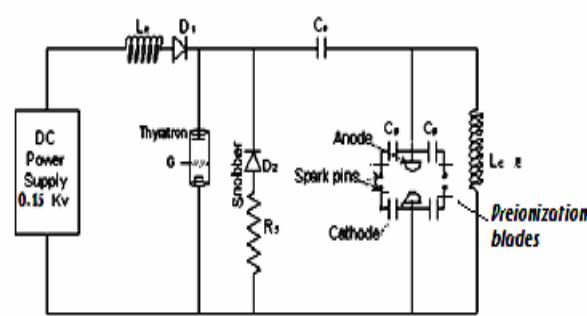


شکل ۱. مقطع الکترودها و نحوه قرار گرفتن خازنهای در کنار الکترودها.



شکل ۴. انرژی خروجی بر حسب نرخ تکرار برای سه ضریب بازتابش مختلف آینه خروجی.

و به شماره ۴۰۵۰A می‌باشد. خازن ذخیره ساز اصلی Cs بین ۱۳/۲ تا ۲۵ نانو فاراد، L = ۰/۵ mH و Lg = ۱۰۰ mH می‌باشند. جهت جلوگیری از برگشت پالس از روی الکترودها از یک ترکیب مقاومت-دیود، موسوم به استنبر^۱ استفاده شده است.



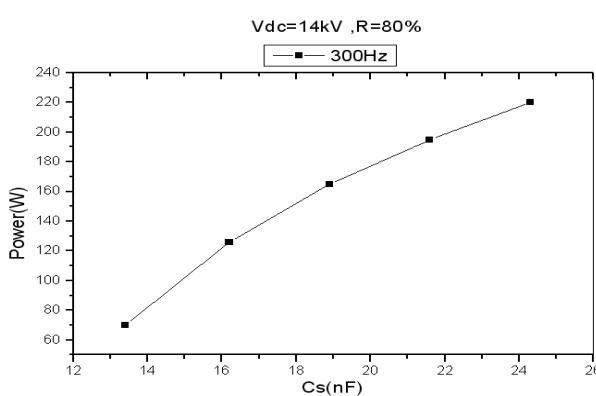
شکل ۳. نمای کلی مدار دمش لیزر.

آنها از یکدیگر، هردو $1/4\text{cm}$ است. خازنهای پیش یونش ۱۵ جفت و در مجموع $4\text{ نانوفاراد طرفیت دارند}$. دهانه گپ جرقه 3mm در نظر گرفته شده است. نحوه قرار گرفتن خازنهای فوق در کنار الکترودها و همچنین مقطع الکترودها در شکل ۱ آمده است. نمای کلی محفظه نیز در شکل ۲ نشان داده شده است.

نسبت مخلوط گازها برای گازهای دی اکسید کربن، نیتروژن و هلیوم با خلوص ۹۸ درصد به ترتیب ۱، ۱ و ۸ می‌باشد. حجم کل محفظه 160000cm^3 و حجم کانال تخلیه الکتریکی 166cm^3 است. کاوک لیزر به طول $1/15\text{m}$ و از دو آینه، یکی در عقب، مقعر و از جنس مس با پوشش طلا و شعاع انحنای 10m و دیگری در جلو، به صورت تخت، و به ترتیب از سه جنس مختلف، ژرمانیوم طبیعی بدون پوشش با ضریب بازتاب 45% در صد درصد، زینک سولوناید پوشش دار با ضریب بازتابش 80% در صد و ژرمانیوم پوشش دار با ضریب بازتابش 60% در صد درصد تشکیل شده است. مدار الکتریکی مدولاتور استفاده شده، ساده شده نمونه‌های قبلی است [۱۴] و در شکل ۳ نشان داده شده است.

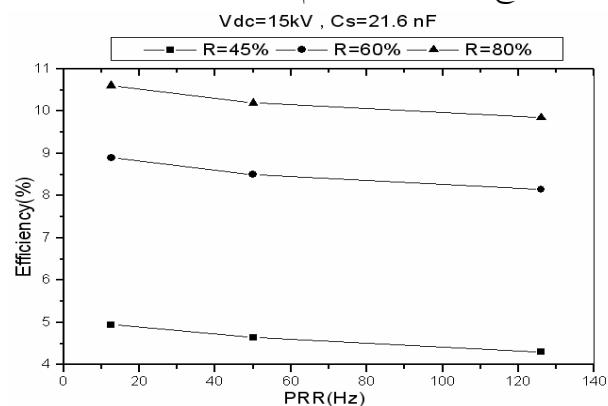
کلید اصلی استفاده شده از نوع کلید گازی موسوم به تایروtron،

^۱ Snuber

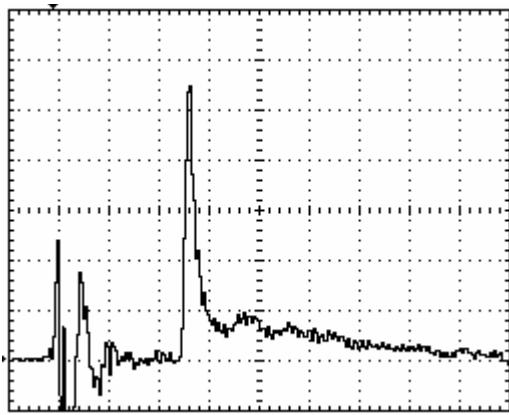


شکل ۶. توان خروجی لیزر بر حسب ظرفیت خازن اصلی در نرخ تکرار ۳۰۰ هرتز با ۸۰٪ بازتابش آینه خروجی.

با افزایش نرخ تکرار، ناشی از گرم شدن گاز است.



شکل ۵. بهره لیزر بر حسب نرخ تکرار در ضریب بازتابشی م مختلف آینه خروجی لیزر.



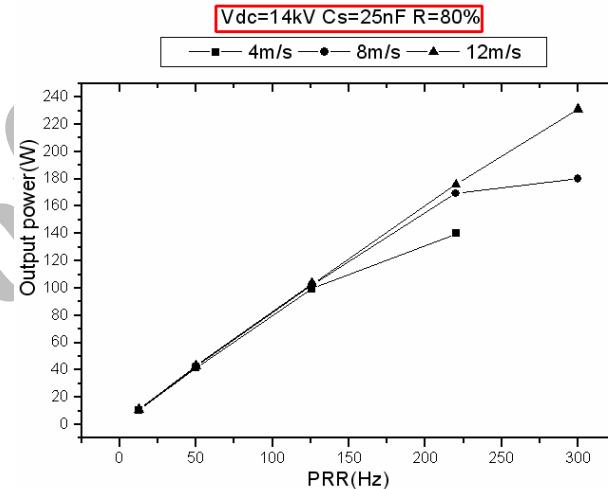
شکل ۸. تپ لیزر برای $C_s = 21.6 \text{ nF}$ و ولتاژ ۱۵ کیلوولت و نرخ تکرار ۱۲/۶ هرتز (هر واحد محور عمودی ۲ مگا وات و هر واحد محور افقی ۲۵۰ نانوثانیه می‌باشد).

شکل ۸ تپ لیزر با قله ۱۱ مگا وات و پهنای ۶۰ نانوثانیه را نشان می‌دهد.

نرخ تکرار ۳۲۰ هرتز، انرژی در هر پالس 10^{30} میلی جول ، قله توان ۱۱ مگا وات و توان متوسط ۲۲۰ وات، ثبت شده است.

سپاسگزاری

از آقای دکتر جلوانی به خاطر راهنماییهای علمی و فنی تشکر می‌کنیم. این کار توسط شرکت فناور آن نور ایزار حمایت مالی شده است.



شکل ۷. آستانه عدم یکنواختی دشواری برحسب سرعت گاز با ۸۰٪ بازتابش آینه خروجی.

شکل ۶ تغییرات توان خروجی لیزر در نرخ تکرار ۳۰۰ هرتز را نسبت به تغییرات ظرفیت خازن C_s مشخص می‌کند. محدودیت ظرفیت خازن اصلی و ولتاژ شارژ آن به خاطر محدودیت تحمل توان الکتریکی توسط تایروترون و منبع تغذیه می‌باشد. شکل ۷ وابستگی یکنواختی دشواری در بهترین نتایج به دست آمده را به طور جداگانه با بهره $10/6$ درصد برای نسبت انرژی خروجی لیزر به انرژی ذخیره شده در نرخ تکرارهای مختلف به سرعت چرخش گاز را نشان می‌دهد.

مراجع

- Eindhoven, Netherlands* (2005).
۱۱. کاوه سیلانخوری و همکاران، مقاله نامه کنفرانس فوتونیک، تهران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران (۱۳۸۵).
 ۱۲. مجید آرام و همکاران، مقاله نامه کنفرانس فوتونیک، تهران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران (۱۳۸۵).
 ۱۳. منصور زند و همکاران، مقاله نامه کنفرانس فیزیک شاهروند، دانشگاه شاهروند (۱۳۸۵).
 ۱۴. منصور زند، مقاله نامه کنفرانس فیزیک خرم‌آباد، دانشگاه لرستان، (۱۳۸۴).

1. G A Baranov, A A Kuchinsky, *Quantum Electron.*, **35** (2005) 219.
2. A J Beaulieu, "High peak power gas lasers", *Proc. IEEE*, (1971) 226-31.
3. R L Carlson, *IEEE J. Quantum Electron. QE-17*, (1981) 1662.
4. L Schachter, et al., *Phys. Lett. A* **205** (1995) 355.
5. V A Gorobetz, V O Petukhov, *Quantum Electron.*, **25** (1995) 489.
6. H Seguin, *Appl. Phys. Lett.*, **L 21** (1972) 414.
7. T S Fahlen, *IEEE J. Quantum Electron. QE-15* (1979) 311.
8. S Sumida, et al., *Appl. Phys. Lett.*, **33** (1978) 913.
9. W Long, et al., *IEEE J. Quantum Electron. QE-15*, (1979) 327.
10. M Kavian, et al., *XXVII ICPIG conference*,